

**ST02-27G1**

27V 200W

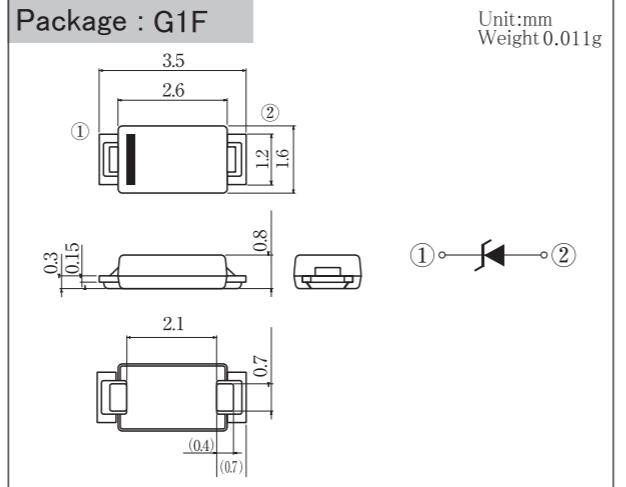
## 特長

- ・1Wクラス
- ・小型SMD
- ・車載用途も対応可能

## Feature

- ・1W Class
- ・Small SMD
- ・Available for automotive use

## ■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

## ■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T<sub>1</sub>=25°C / unless otherwise specified)

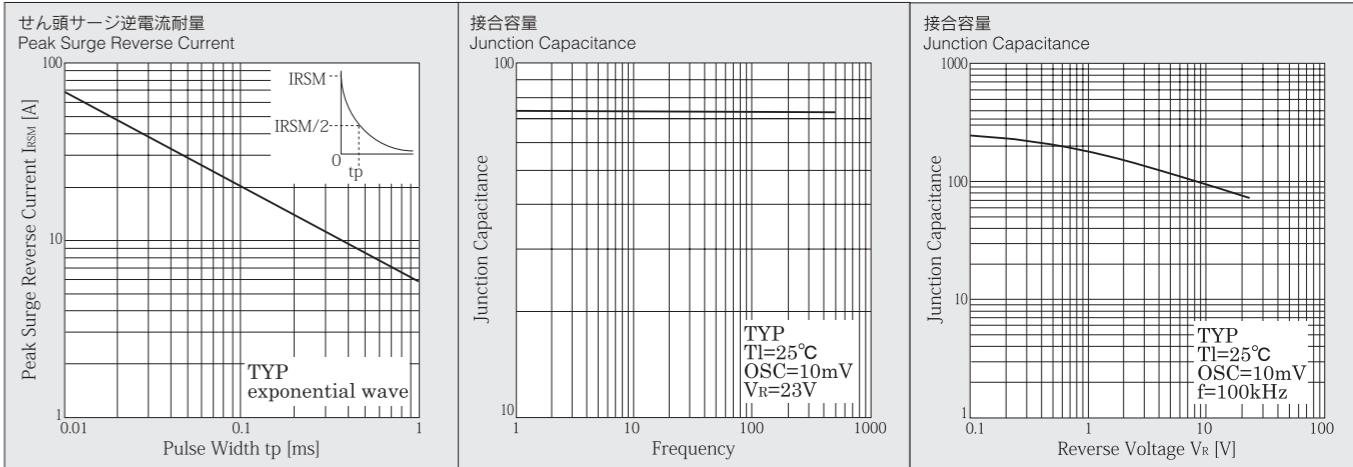
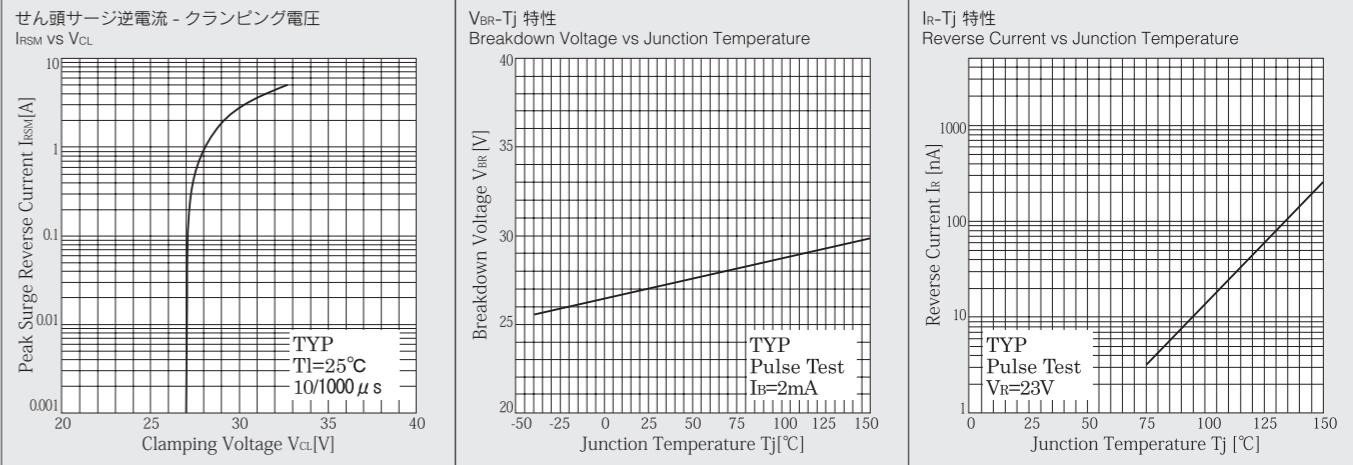
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規定値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage temperature	T <sub>stg</sub>		-55~150	°C
接合部温度 Operating junction temperature	T <sub>j</sub>		150	°C
せん頭サージ逆電流 Maximum surge reverse current	I <sub>RSM</sub>	10/1000μs 非繰り返し 10/1000μs Non-repetitive	5.5	A
せん頭サージ逆電力 Maximum surge reverse power	P <sub>RSM</sub>	10/1000μs 非繰り返し 10/1000μs Non-repetitive	200	W
許容損失 Power Dissipation	P		1	W
連続印加電圧 Maximum reverse voltage	V <sub>RM</sub>		23	V

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 T<sub>1</sub>=25°C / unless otherwise specified)

動作開始電圧 Breakdown voltage	V <sub>BR</sub>	I <sub>R</sub> =2mA	MIN. 25.1 TYP. 27.0 MAX. 28.9	V
制限電圧 Restriction voltage	V <sub>CCL</sub>	10/1000μs I <sub>pp</sub> =5.5A	MAX. 37.0	V
逆電流 Reverse current	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =23V, パルス測定 V <sub>R</sub> =23V, Pulse measurement	MAX. 5.0	μA
熱抵抗 Thermal resistance	θ <sub>jl</sub>	接合部・リード間 アリト基板実装 junction to lead On glass-epoxy substrate	MAX. 20	°C/W
	θ <sub>ja</sub>	接合部・周囲間 アリト基板実装 160mm <sup>2</sup> junction to ambient On glass-epoxy substrate 160mm <sup>2</sup>	MAX. 120	

## G1F Package

## ■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



\*Sine waveは50Hzで測定しています。  
\*50Hz sine wave is used for measurements.  
\*半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。  
Typicalは統計的な実力を表しています。  
\*Semiconductor products generally have characteristic variation.  
Typical a statistical average of the devices ability.